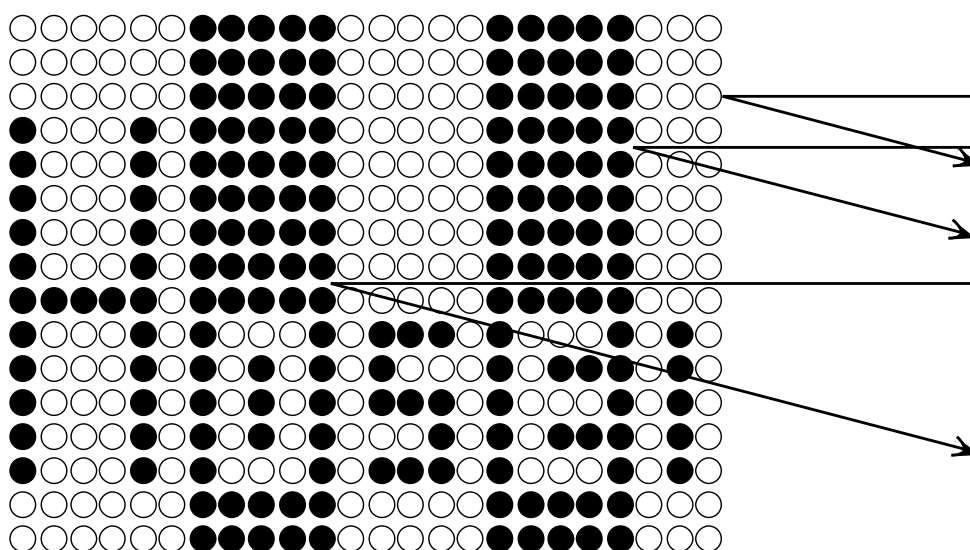


# 第 28 回法政大学 イオンビーム工学研究所シンポジウム

The 28th Symposium on Materials Science and Engineering  
Research Center of Ion Beam Technology  
Hosei University

## PROGRAM



期日 2009 年 12 月 9 日(水)  
会場 法政大学 小金井キャンパス  
主催 法政大学イオンビーム工学研究所

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| I                                                            | 10 : 30 ~ 12 : 00 |
| <b>招待講演 I</b>                                                |                   |
| 世界天文年特別講演 レーザー干渉計で宇宙からの重力波を探す<br>国立天文台                       | (45 分)<br>藤本 眞克   |
| <b>招待講演 II</b>                                               |                   |
| 液相・界面へのナノ照射：先細ガラスキャピラリーの応用可能性<br>東京大学、理化学研究所                 | (45 分)<br>山崎 泰規   |
| 昼食                                                           | 12 : 00 ~ 13 : 00 |
| II                                                           | 13 : 00 ~ 13 : 45 |
| <b>招待講演 III</b>                                              |                   |
| ナノサイズ粒子の密度と重さを測る<br>—クリーンディーゼルエンジン開発に向けた環境対応技術—<br>産業技術総合研究所 | (45 分)<br>齊藤 敬三   |
| 休憩                                                           | 13 : 45 ~ 14 : 00 |
| III ショート講演 (各 5 分)                                           | 14 : 00 ~ 15 : 05 |

- Fe イオンを注入した酸化スズ薄膜の強磁性発現とアニール効果  
東京大学、Forschungszentrum Dresden-Rossendorf e. V\*      ○野村 貴美、H. Reuther\*
- イオン注入により作製した SiO<sub>2</sub> 薄膜中シリコンナノ結晶の発光特性における UV 照射  
および RTA 処理の効果  
金沢大学、愛知教育大学\*、University of Sussex\*\*      ○浜 貴幸、岩山 勉\*、D. E. Hole\*\*
- 中電流型イオン注入装置を用いた CNT 形成法について  
神奈川大学      ○有馬 広記、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- イオン注入法により作製した GaAs:Er 中の深い準位と発光特性  
明治大学      ○伊藤 圭佑、植草 新一郎
- 論理 LSI で発生する SET パルスによるソフトエラー率の推定  
日本原子力研究開発機構、宇宙航空研究開発機構\*  
○牧野 高紘、小野田 忍、平尾 敏雄、大島 武、小林 大輔\*、廣瀬 和之\*
- ホモエピタキシャルマイクロ波プラズマ CVD ダイヤモンド薄膜の各種分析評価  
神奈川大学      ○加藤 健一、本杉 太郎、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治
- RBS analysis of Au/(Pt)/Ti multilayer grown on C(001) surfaces  
Kanagawa University, ○Yasushi Hoshino, Ken-ichi Kato, Yasunao Saito and Jyoji Nakata
- 酸素化処理による B-doped(111)ダイヤモンド表面の電気的特性  
コメット\*、科学技術振興機構\*\*、産業技術総合研究所\*\*\*  
○李 成奇\*\*、大串 秀世\*\*\*、山崎 聡\*\*\*
- イオン注入 SiC-MESFET の耐圧改善  
新日本無線      ○片上 崇治、小野 修一、新井 学
- 粒子線誘起ガンマ線分光 (PIGE) による固体高分子型燃料電池中のフッ素の分析  
東京都市大学、東京工業大学\*、佐野 健二、川畑 俊明、鳥山 保、若林 英彦、  
○川崎 克則\*、服部 俊幸\*、小野田 充、高木 靖雄、実吉 啓二\*、小栗 慶之\*

11. Ni 薄膜中の水素原子に対して異なる検出器配置で行った ERDA 測定の比較  
産業技術総合研究所      ○木野村 淳、安 白、鈴木 良一、福山 誠司、横川 清志
12. Graphite Nanospines を電子源とした小型 X 線管の試作と評価  
鬼塚硝子、静岡大学\*      ○定塚 淳生、中村 智宣、鬼塚 好弘、三村 秀典\*
13. 等温部分溶融法により作製した Bi2212 丸線の臨界電流特性  
コメット、物質・材料研究機構\*      ○高橋 健一郎、中根 茂行\*、北口 仁\*

|    |                 |
|----|-----------------|
| 休憩 | 15 : 05~15 : 20 |
|----|-----------------|

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| IV ポスターセッション | 15 : 20~16 : 45 |
|--------------|-----------------|

14. Fe/Si 多層膜における Ar イオン照射効果  
法政大学、産業技術総合研究所\*、島根大学\*\*、久留米工業大学\*\*\*、東京都市大学\*\*\*\*  
○中谷 聡、小池 正記\*、本多 茂男\*\*、林 伸行\*\*\*、鳥山 保\*\*\*\*、坂本 勲
15. Fe イオン、Au イオン共注入 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> におけるレーザー光照射効果  
久留米工業大学、法政大学\*、日本製鋼所\*\*、東京大学\*\*\*、東京都市大学\*\*\*\*、日立金属\*\*\*\*\*  
林 伸行、○高田 純一\*、石田 智也\*、清野 俊明\*\*、野村 貴美\*\*\*、  
鳥山 保\*\*\*\*、森脇 隆行\*\*\*\*\*、坂本 勲\*
16. イオン注入を用いた 4H-SiC ダイオードの熱処理による特性ばらつきの検討  
法政大学      ○中村 善、渡部 優貴、田島 卓、佐藤 政孝、中村 徹
17. イオン注入 4H-SiC BJT の高電流利得化  
法政大学      ○田島 卓、中村 善、渡部 優貴、佐藤 政孝、中村 徹
18. プラズマ処理によるイオン注入 SiC の表面荒れの低減  
法政大学      ○杉本 尚丈、佐藤 政孝、中村 徹
19. 自己整合型イオン注入 GaN MISFET  
法政大学      ○長谷川 一也、野本 一貴、中村 徹
20. GaN への Si イオン注入に関する研究  
法政大学      ○豊田 裕輝、田島 卓、野本 一貴、中村 徹
21. 二重イオン注入 GaN/AlGaIn/GaN HEMT の低周波雑音特性評価  
法政大学      ○花輪 祐介、菱谷 守、野本 一貴、中村 徹
22. イオン注入 AlGaIn/GaN HEMT のフィールドプレート構造の最適化  
法政大学      ○大津 陽祐、渡部 優貴、野本 一貴、中村 徹
23. シリコンイオン注入 ZnO バルク単結晶のラザフォード後方散乱による  
結晶性の評価：低抵抗化の起源  
法政大学、大阪教育大学\*      ○井澤 佑介、松本 孝治、栗山 一男、串田 一雅\*
24. 炭素イオン注入 ZnO バルク単結晶の核反応分析：低抵抗化の起源  
法政大学、大阪教育大学\* 産業技術総合研究所\*\*  
○井澤 佑介、松本 孝治、尾賀 孝宏、栗山 一男、串田 一雅\*、木野村 淳\*\*
25. Na-H-C<sub>60</sub> 化合物の構造と物性における水素の役割  
法政大学      ○大波 英幸、緒方 啓典

26. ポリメタクリル酸樹脂固体電解質のラザフォード後方散乱法による評価

—全固体型リチウムイオン二次電池の微小化—

法政大学、大阪教育大学\*、

○山田 侑輝、川村 拓也、井澤 佑介、栗山 一男、串田 一雅\*

27. MOCVD 法による  $\text{CeO}_2$  薄膜形成時の反応機構—水分子 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) の影響—

法政大学、コメント\*

○大塚 健太郎、伊豆 崇則、木樽 智也、島田 洋希、内田 健啓、鈴木 摂\*、山本 康博

---

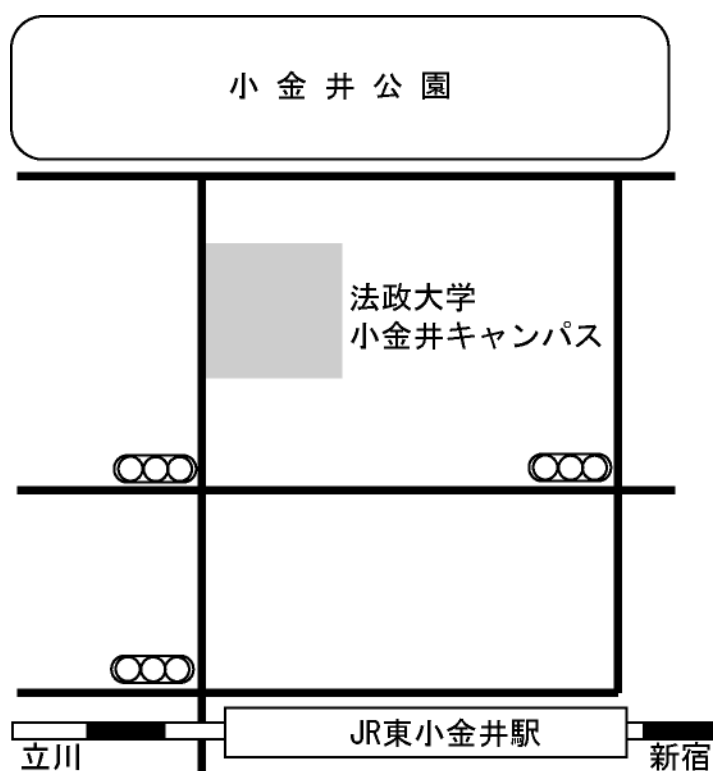
17:00～

懇親会

管理棟 1F 教職員食堂にて

---

**交通案内**



JR 東小金井駅北口より徒歩12分  
京王バスまたは CoCo バス「法政大学」下車

**法政大学イオンビーム工学研究所**

〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2

Tel: 042-387-6094 Fax: 042-387-6095

E-mail: sympo@ionbeam.hosei.ac.jp